



半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 26 卷 第 11 期 2005 年 11 月

目 次

研究快报

- AlGaIn/GaN High Electron Mobility Transistors on Sapphires with f_{max} of 100GHz Li Xianjie, Zeng Qingming, Zhou Zhou, Liu Yugui, Qiao Shuyun, Cai Daomin, Zhao Yonglin, and Cai Shujun (2049)
- A Wavelength Tunable DBR Laser Integrated with an Electro-Absorption Modulator by a Combined Method of SAG and QWI Zhang Jing, Li Baoxia, Zhao Lingjuan, Wang Baojun, Zhou Fan, Zhu Hongliang, Bian Jing, and Wang Wei (2053)
- Lumped Equivalent Circuit of Planar Spiral Inductor for CMOS RFIC Application Zhao Jixiang (2058)
- An Efficient Test Data Compression Technique Based on Codes Fang Jianping, Hao Yue, Liu Hongxia, and Li Kang (2062)

研究论文

- Effects of Thickness on Properties of ZnO Films Grown on Si by MOCVD Shen Wenjuan, Wang Jun, Duan Yao, Wang Qiyuan, and Zeng Yiping (2069)
- Growth of Space Ordered 1.3 μ m InAs Quantum Dots on GaAs (100) Vicinal Substrates by MOCVD Liang Song, Zhu Hongliang, Pan Jiaqing, and Wang Wei (2074)
- Characteristics of a 0.1 μ m SOI Grooved Gate pMOSFET Shao Hongxu, Sun Baogang, Wu Junfeng, and Zhong Xinghua (2080)
- A Fractional-N CMOS DPLL with Self-Calibration Liu Sujuan, Yang Weiming, Chen Jianxin, Cai Liming, and Xu Dongsheng (2085)
- 空间有序的量子点超晶格的红外吸收 孙永伟 马文全 杨晓杰 屈玉华 侯识华 江德生 孙宝权 陈良惠 (2092)
- 小振幅近似与形变超晶格系统的动力学稳定性 罗诗裕 邵明珠 (2097)
- Hg_{1-x}Cd_xTe 外延薄膜表面对红外透射光谱的影响 张小雷 孔金丞 马庆华 吴军 杨宇 姬荣斌 (2102)
- 锗对重掺硼直拉硅中氧沉淀的影响 江慧华 杨德仁 田达晰 马向阳 李立本 阙端麟 (2107)
- UHV-CVD 生长的 SiGe 多量子阱在热光电池领域的应用 孙伟峰 叶志镇 朱丽萍 赵炳辉 (2111)
- 多晶硅薄膜的高温压阻效应 霍明学 刘晓为 张丹 王喜莲 宋明浩 (2115)
- 量子点的原子力显微镜测试结果分析: 数学形态学的实现 金峰 鲁华祥 李凯 陈涌海 王占国 (2120)
- 水浴法制备形貌可控的一维 ZnO 纳米和微米棒 张琳丽 郭常新 陈建刚 胡俊涛 (2127)
- 渠道火花烧蚀法制备 In₂O₃: Mo 透明导电薄膜 黄丽 李喜峰 张群 缪维娜 张莉 章壮健 华中一 (2133)
- 超高真空化学气相生长用于应变硅的高质量 SiGe 缓冲层 吴贵斌 叶志镇 刘国军 赵炳辉 崔继峰 (2139)
- GaN HFET 沟道热电子隧穿电流崩塌模型 薛舫时 (2143)
- 具有 p 型埋层 PSOI 结构的耐压分析 段宝兴 张波 李肇基 (2149)
- 屏蔽槽 SOI 高压器件新结构和耐压机理 罗小蓉 李肇基 张波 郭宇锋 唐新伟 (2154)
- 阶梯掺杂薄漂移区 RESURF LDMOS 耐压模型 李琦 张波 李肇基 (2159)
- MOS 器件多晶硅栅量子效应的解析模型 代月花 陈军宁 柯导名 孙家沁 徐超 (2164)
- 深亚微米 pMOS 器件 HCI 退化建模与仿真方法 李康 郝跃 刘红侠 方建平 薛鸿民 (2169)
- III-V 族化合物 HBT 建模 刘军 孙玲玲 (2175)
- 一种采用开关阶跃电容的压控振荡器 (下): 电路设计和实现 唐长文 何捷 闵昊 (2182)
- Ku 波段源极调谐 HFET MMIC VCO 王绍东 高学邦 吴洪江 吴阿惠 (2191)
- EIS 型半导体生化传感器 EI 界面势的理论模拟 贾芸芳 牛文成 张福海 刘国华 俞梅 (2196)
- 一种新型的 CMOS 温度传感器 张洵 王鹏 靳东明 (2202)
- 硅基 CoZrO 铁氧体磁膜结构 RF 集成微电感 杨晨 刘锋 任天令 刘理天 冯海刚 王自惠 龙海波 于军 (2208)
- 大功率 GaInP/AlGaInP 半导体激光器 徐云 郭良 曹青 宋国峰 甘巧强 杨国华 李玉璋 陈良惠 (2213)
- Si 基热光可调谐窄带平顶滤波器 左玉华 蔡晓 毛容伟 王启明 (2218)
- 硅基 M \times N 型微环阵列谐振滤波器的理论分析 闫欣 马春生 徐元哲 王现银 鄂书林 张大明 (2223)
- 一种 57.6mW, 10 位, 50MS/s 流水线操作 CMOS A/D 转换器 黄飞鹏 王静光 何济柔 洪志良 (2230)
- 位置数为 2 的多模干涉耦合器相位关系分析 孙一翎 江晓清 杨建义 王明华 (2236)
- 利用正多项式响应曲面模型实现模拟电路参数自动生成 高雪莲 石寅 (2241)
- 一种用于模数转换器的高性能差分参考电压源 李丹 叶菁华 洪志良 (2248)
- 光探测器 TO 封装的高频分析与改进 张尚剑 刘戡 温继敏 祝宁华 (2254)
- 抛光液中缓蚀剂对铜硅片的影响 李秀娟 金珠吉 康仁科 郭东明 苏建修 (2259)

技术进展

- MOCVD 法制备 ZnO 同质发光二极管 叶志镇 徐伟中 曾昱嘉 江柳 赵炳辉 朱丽萍 吕建国 黄靖云 汪雷 李先抗 (2264)